γ射线探测器的能量标定

石宗仁 中国原子能科学研究院 2018,3 7, 在高能所的报告

1. 引言

- 1.1 γ射线探测器
- 有机闪烁体, H,C,O的化合物。γ射线与它们主要是Compton散射。时间响应快,效率低,没有全能峰,但易制成大面积,造价低。Ey=661keV的能量分辨率8-25%。
- 无机闪烁体。LaBr3(Ce), NaI(TI), CsI(TI)。效率高,有全能峰,造价高。Eγ=661keV的能量分辨率3-15%。
- 半导体。纯半导体Ge和Si,化合物半导体CdTl等。效率中等,有全能峰,造价高。 Ge和Si 需低温运行。
- 由于Si的原子序数低14, 用于几百keV以下的x-射线探测。
- 根据效率,能量、时间和位置分辨率,粒子鉴别本领和固有的放射性杂质等要求选取探测器。

探测器的响应函数

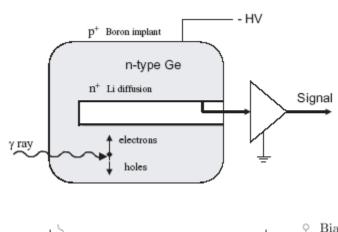
- 一个单能γ射线在探测器内的能量沉积谱用总计数归一称响应函数 ,即归一的信号输出的脉冲幅度谱。
- 在探测器中,γ射线与探测介质的相互作用、次级电子和电子-空 穴对等的行为决定了响应函数,它是连续的。
- 采用MC程序Geant4模拟响应函数。
- 响应函数中的单色部分称峰形函数。
- 建立响应函数和峰形函数与γ射线能量的关系,分别用于解连续的和分立的γ射线能谱。
- 响应函数的单色化技术: 反康、对谱仪和两者的复合。

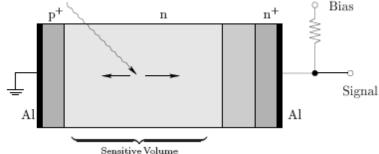
解谱

- 从测量的脉冲幅度谱求出γ射线能谱称为解谱。关键是解重峰。
- 目的是确定峰位和峰面积。然后利用标定的能量和效率曲线,导出γ射线的能量及其强度。
- 实验上测量的脉冲谱P(E)可写成如下的积分式
- $P(E) = \int f(E_{\gamma}) R(E-E_{\gamma}) dE_{\gamma} + B$, $B = \sum_{i} a_{i} E^{i}$.
- 其中: E表示脉冲幅度或道数; R(E-E_γ)是实验测定或MC计算的响应函数; f(E_γ)是入射到探测器的γ射线能谱; B是本底。
- · 当 Y 射线能谱是分立的,解谱相对简单。
- 经数据光滑, 寻峰, 高斯峰形拟合等步骤。
- 一般,能量的不确定度~keV,强度为百分之几--几十。

1.2 HPGe探测器

- n-型Ge几keV以上, 抗辐照及损 伤可恢复.
- p-型Ge几十keV以上,有较好的 能量分辨率.
- 在几何上,常用单开端同轴和 平面两种HPGe。
- 单开端同轴可认为由平面和真同轴两部分组成.
- 还有井型、外电极分割和点接 触等类型的HPGe探测器.



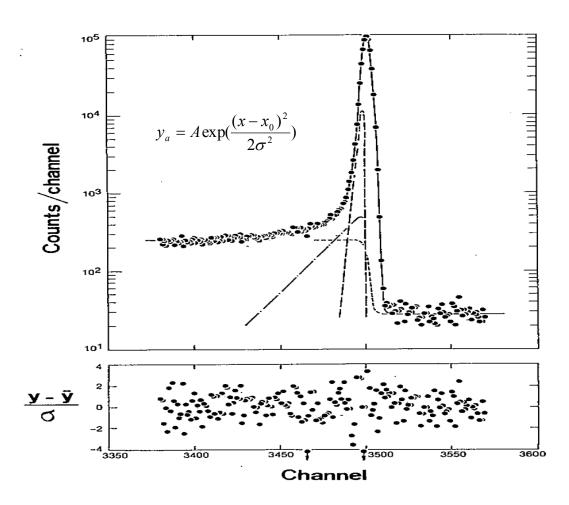


HPGe探测器的性能指标

- 能量分辨率~2keV。噪声~1.4keV, 电子-空穴对的统计~1.5keV。
- 时间分辨率~5ns。与能量范围有关。
- 位置分辨率。普通的HPGe没有位置分辨本领。
- 峰/康比~60。
- 相对效率是⁶⁰Co源离探测器表面25cm时相对3"×3" Nal(Tl)的效率。最大相对效率达200%。
- 效率~正比于体积。
- HPGe是电离室,它的信号脉冲上升时间, ~200ns,与e-h产生位置有关。中等速度的探测器。
- HPGe探测器的性能指标是用⁶⁰Co放射源的Eγ=1.33MeV测量的。
- 有机和无机闪烁体的性能指标是用¹³⁷Cs放射源的Eγ=0.661MeV测量的。

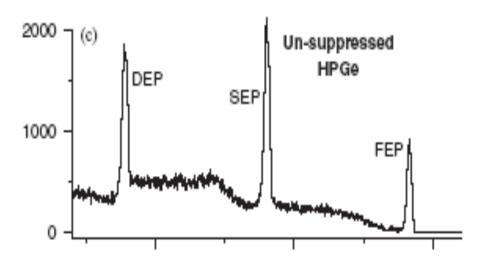
HPGe的峰形函数

- 峰形函数由高斯分布G、 低能指数尾T和平台erfc 等三部分组成。
- 图是Helmer等人的拟合 函数。G+2T+erfc.
- T和erfc来自电荷收集不完全,如陷阱、表面道效应、电子的边界逃逸,及光电和对效应产生电子的韧致辐射光的逃逸、多次Compton散射及弹道亏损等。
- 为获得准确的重峰的峰位和面积采用三部分函数,但计算时间长。
- 一般,采用G确定它们。



HPGe对高能y射线的响应

- · 一般,放射性源的γ射线能量<3MeV,称低能源。
- · >3MeV称高能γ射线,它们主要来自核反应。
- 高能γ射线与探测介质产生e+e-对效应显著。响应函数中有全能、 单逃逸和双逃逸三个单色峰,都可用于测定γ射线能量。
- 由于逃逸现象,在10-20MeV响应函数可能更复杂。



2. 能量标定

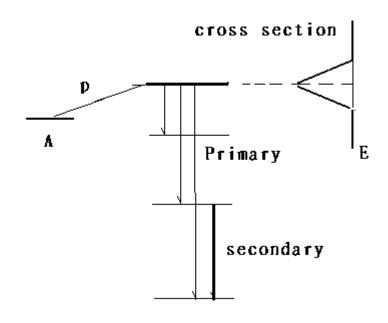
- 如下步骤:
- 选取标准γ射线源,
- 实验测量,
- 解谱得到标准γ射线的峰位,即测量的能量,
- 对测量的γ射线能量做修正,
- 建立γ射线能量与测量能量的关系曲线,
- 评估γ射线能量的不确定度。

2.1 选择标准γ射线源

- 由多个实验测量, 经评价和推荐的数据称标准。分初级和次级标准。
- 放射性同位素标准源. 能量范围 $E\gamma$ <3MeV,能量不确定度 $\sigma \leq 10eV$ 。
- Eγ<3MeV的标准γ射线源容易得到。
- Ey>3MeV的有两个。⁵⁶Co (486. 5-3611. 7keV, T_{1/2}=77. 3d, ⁵⁶Fe (p, n) ⁵⁶Co) 和⁶⁶Ga (833. 6-4807. 0keV; T_{1/2}=9. 5h, ⁶³Cu (α, n) ⁶⁶Ga) 能发射>3MeV高能γ射线,但制做困难和寿命短。
- 热中子辐射俘获反应高能γ射线标准源。 $E_{\gamma}<11$ MeV, $\sigma \leq 100$ eV。
- ³⁵CI, ¹⁴N (n, γ) 分别产生最高能为8. 6和11MeV的多线源。
- 轻核质子辐射俘获反应 (p, γ) γ射线标准源, $E\gamma > 10 MeV$, $\sigma \le 1 keV$ 。
- 7 Li, 11 B, 23 Na, 27 Al (p, γ) 等是标准。特别 11 B(p, γ) 能产生10MeV以上的γ射线。它适合10-20MeV γ射线的标定。
- 标记韧致辐射高能γ射线源。
- Compton背散射光源。

2.1.1 A(p, γ) 共振反应

- 轻核质子共振辐射俘获反应
- 共振能级和宽度
- 共振能级退激放射出初级γ射线, 随后的称次级γ射线。
- 初级γ射线的能量与共振宽度有 关。次级与宽度无关。
- 宽度与其寿命有heisenberg关系,
- $\Gamma \cdot \tau = h/4\pi$.

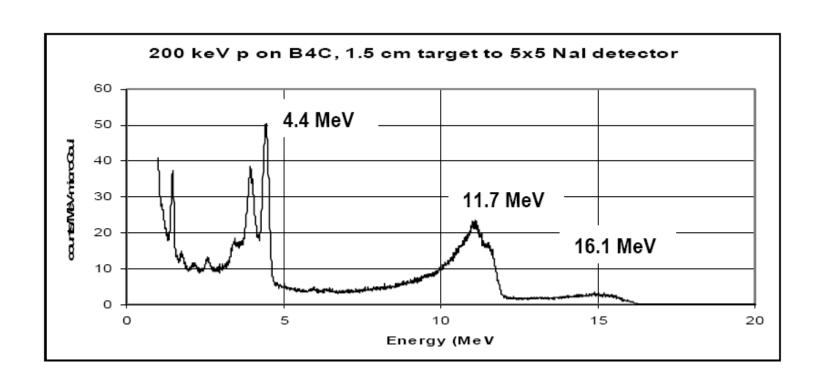


质子共振辐射俘获反应

- 低能质子、较高产额的(p, γ)共振辐射俘获反应。
- 8个Eγ=4-18MeV。

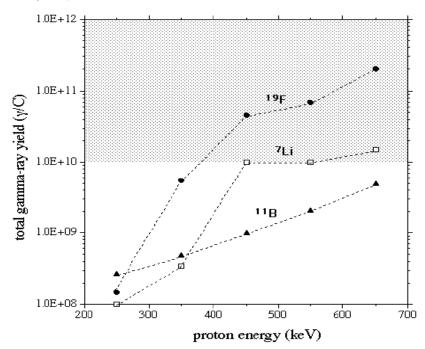
Reaction	E _γ (MeV)	E _p (keV)	σ (mb)	Γ (keV)	Target
$^{11}B(p,\gamma)^{12}C$	4.4, 11.7 , 16.1	163	0.16	7	Easy
$^{11}{ m B}({ m p},\!\gamma)^{12}{ m C}$	4.4, 12.2	675	0.05	322	Easy
$^{13}C(p,\gamma)^{14}N$	4.11, 8.06	550	1.44	33	Moderate
¹⁹ F(p,αγ) ¹⁶ O	6.1 , 6.9, 7.1	340 484 597 672	160 32 7 57	3 1 30 6	Difficult
$^{19}\text{F}(p,\alpha\gamma)^{16}\text{O}$	1.6, 11.9	672	0.5	6	Difficult
⁷ Li(p,γ) ⁸ Be	14.8, 17.7	441	6	12	Moderate

¹¹B(p, γ) ¹²C的γ射线



γ射线产额

• 厚靶的每库伦入射质子的γ射线产额。10μA质子束流累积达到10需 ~30h。测量时间长。



2.1.2 非共振¹¹B(p, γ)反应

- 利用¹¹B(p, γ) ¹²C反应获得10MeV以上的单色γ射线。
- 反应Q=15957.17±0.33keV。
- 截面小,~µb。
- 从连续态跃迁到¹²C基态和第一激发态的初级γ射线能量用下式计算。

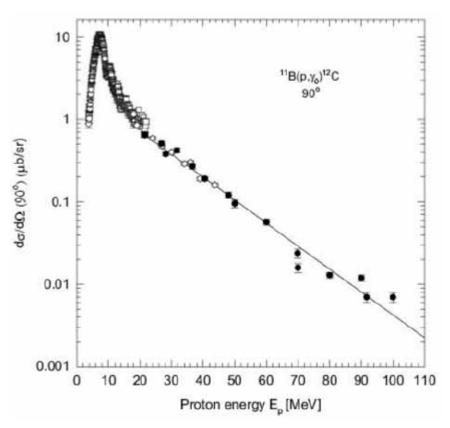
$$E_{\gamma 0} = (0.92)E_p + 15.957$$
 MeV,

$$E_{\gamma 1} = (0.92)E_p + 11.518 \text{ MeV}$$

$$0.92 = \text{mass}_{boron}/(\text{mass}_{boron} + \text{mass}_{proton})$$

非共振的 11 B(p, γ) 12 C反应

在90°的γ₀的微分截面。Ep=4-18MeV, σ(90°)>1μb/sr.



如何选择(p, γ)源?

- 应考虑下面的因素:
- 共振反应的截面,决定计数率;
- 共振宽度和寿命,决定初级γ射线的FWHM和Doppler效应;
- 非共振(p, γ)反应可得到更高能量的γ射线,反应截面小;
- γ射线的角分布;
- 是否有中子产生,本底:
- 靶是否容易制做;
- 加速器的能量、束流强度的稳定性;
- 能量的不确定度等。
- 选取尽可能多的γ射线能量,得到宽能区的能量曲线。

2.1.3 中子和y射线混合源

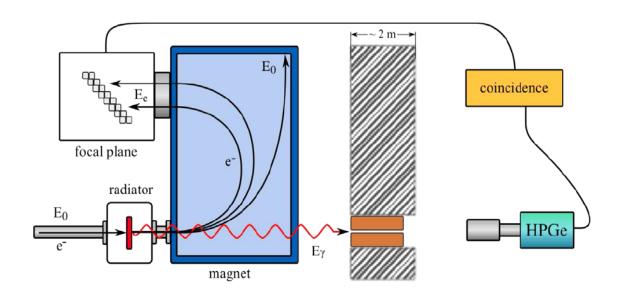
- 同时产生中子和γ射线的非共振反应。
- ${}^{11}B(d, n\gamma){}^{12}C$, E γ : 4. 43, 15. 1MeV.
- ${}^{11}B(d, p\gamma){}^{12}B$, E γ : 0. 95, 1. 67MeV.
- ²⁴¹Am ⁹Be的中子和4. 43MeVγ射线源.
- ²³⁸Pu-¹³C的中子和6. 13MeVγ射线源.
- 标定有机闪烁体。
- 中子和γ射线同时用于检测--反恐。

(p, γ)和(n, γ)反应

- 评价和推荐的多线源
- 27 AI(p, γ) 28 Si, 共振Ep=992keV, Γ =70eV, Eymax: 10762.9。
- $^{14}N(p, \gamma)^{15}0$, 共振Ep=1058keV, Γ =3900eV, Eymax:8281.5(5)。
- 23 Na (p, γ) 24 Mg, 共振Ep=1417keV, Γ=90eV, Εγmax:8925.55。
- $^{14}N(n_{+h}, \gamma)$ ^{15}N , Ey: 10829. 110(59), 9148. 95(9), 8310. 156(39) .
- 35 CI (n_{th}, γ) 36 CI, E γ :8578.53(9),7790.28(8).
- 在<11MeV的能区,利用¹⁴N(n_{th} , γ)和 ²⁷AI(p, γ)标准源校准能量曲线。一般能量不确定度~0.1keV.

2.1.4高能标记的韧致辐射源

• FWHM~30-50keV. L. Schnorrenberger et al. NIMA735 (2014) 19

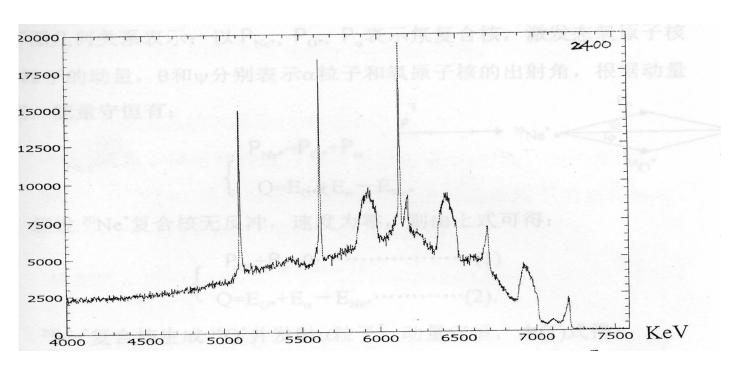


2.2 多普勒效应和核反冲

- · 多普勒 (Doppler) 效应引起γ射线能量的移位和展宽
- 根据能动量守恒,在质子辐射俘获反应中,复合核是沿束流方向运动的。
- 共振能级的寿命τ和复合核在靶中的慢化时间t_m是两个重要的参数。
- 三种情况:τ<< t_m,在飞行的起点衰变发射γ射线;τ>>t_m,停止后衰变;τ~ t_m,前两者之间。
- 多普勒的线形是非对称的。
- $E_{\gamma} = E_0 (1 + v \cos\theta/c) E_0^2/2M$.
- 不同的探测角度,产生能量移位
- $(E_{\gamma} E_0) / E_0 = v \cos\theta/c$,
- 为了克服多普勒移位,探测器放置在θ=90°。
- 探测器的有限张角,产生峰展宽
- \triangle E_{γ} / E₀ =v /c ($\cos\theta_1$ $\cos\theta_2$) .

多普勒效应

• 关注多普勒(Doppler)效应,如何从脉冲幅度谱测定能量。

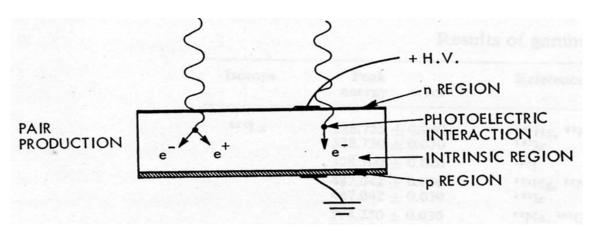


2.3 实验测量

- 严格控制实验条件:
- 源-探测器几何保持一致;
- 主放大器应调节到最佳状态,特别是放大器的时间常数;
- · ADC道数的选择,在保真和计数统计间折衷;
- 控制计数率, 防止计数率效应引起峰位漂移;
- 测量中用放射性¹³⁷Cs和⁶⁰Coγ射线源监测探测器和电子线路的稳定性,或采用内标;
- 加速器束流在空间和能量应稳定;
- 靶的老化和沾污等。
- 标定和测量的实验条件和解谱方法一致。

源-探测器几何

- 场增量效应,电子加速与γ射线入射和电场方向的夹角有关。
- 晶格取向效应,电子-空穴对的产生与γ射线入射和晶轴间的角度 有关,影响峰位和FWHM.
- 由于入射方向的差异,本底中子经H(n,γ)²H反应产生的2223keV和高能γ射线产生的511keV都不适合作为能量标准。可能有几百eV的系统不确定性。可做稳定性监测。
- 保持校准源与待测源的位置尽可能一致。



ADC的道宽

- 为了保证谱的信息不畸变, ADC的道宽应满足Shannon定理: 最大道宽是测量有意义的能量范围中最小FWHM的一半。
- N= $(E_1 E_2) / (FWHM_{min}/2)$
- 有意义的能量范围10-20MeV. 10MeV对应的FWHM_{min}~5keV, N~8000.
- 道数N越多, 信息的保真度越高, 但每道的计数越少, 测量时间越长。
- 为获得每道有较好的计数统计,有时道宽的选取需要在谱的畸变和计数统计间折衷。
- 用¹³⁷Cs和 ⁶⁰Co标定ADC的道宽和零点.

2.4 数据处理-解谱

- 分立的单能γ射线。
- 目的是标定能量。
- 利用全能、单逃逸和双逃逸峰,确定峰极大值的位置。
- 采用高斯分布函数+二次多项式本底拟合峰形,确定峰的位置。
- 测量与标定采用同样的解谱方法。

能量修正

- 反冲核能量修正, 可计算。
- 探测系统不稳定的修正, 用γ射线监测源。

能量曲线

- 函数拟合法
- $E_{\gamma}(x) = ae^{-bx} + \sum_{n=1}^{4} C_{i}x^{i-1}$
- 非线性来源于探测器、ADC和电子学线路。
- 由于非线性的物理过程至今不十分清楚,因此没有函数能真正的描写非线性关系。

残差法

- 峰位和γ射线能量做线性最小二乘法拟合,得到线性参数c和d。
- $E_0(x) = c + dx$
- 测量的峰位与直线数据做差得剩余,
- $\Delta E_{\gamma}(x) = E_{\gamma}(x) E_{0}(x)$.
- $\Delta E_{\gamma}(x)$ 的数量为几个keV。
- 用目测绘制 $\Delta E_{\gamma}(x)$ 与 $E_{\gamma}(x)$ 的关系曲线。

测量能量的不确定度

- 来源:
- 标准γ射线的能量不确定度;
- 峰计数统计引起峰位的不确定度;
- 在非共振(p, γ)反应中,质子能量的不确定度对初级的影响;
- 在非共振(p, γ)反应中,质子在靶中能量损失的不确定度;
- 靶厚不均匀引起质子在靶中能量损失的不确定度等。
- 由于利用单色峰的极大值,即峰位确定γ射线的能量。在足够的计数下,峰位准确性很高,能达到ADC道宽的3%,~1keV。
- 多个单能测量值的线性拟合将近一步减少能量不确定度。

总结

- 采用轻核共振和非共振的 (p, γ) 反应作10-20MeV的 γ 射线源是可行的。特别是 $^{11}B(p, \gamma)$ ^{12}C 反应。
- 需要进一步调研有关(p, γ)反应的参数。
- 估算能量的不确定度。
- 确定实验方案。
- 感谢原子能科学院的陈永静同志的帮助。

• 谢谢!